

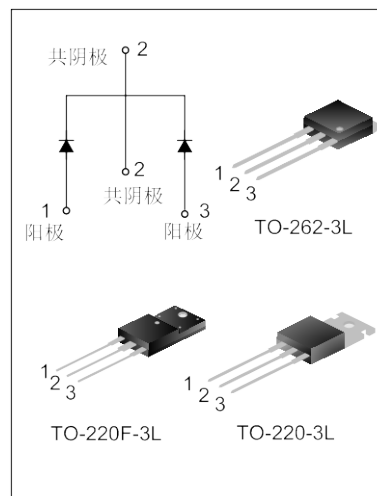
20A、200V肖特基整流管

描述

SBD20C200T/F/K是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中。

特点

- * 具有过压保护的保护环结构；
- * 高电流冲击能力；
- * 低功耗，高效率；
- * 正向压降低。



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SBD20C200T	TO-220-3L	SBD20C200T	无铅	料管
SBD20C200F	TO-220F-3L	SBD20C200F	无铅	料管
SBD20C200K	TO-262-3L	SBD20C200K	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	200	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	20	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	150	A
工作结温	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	1.6	$^{\circ}\text{C/W}$

电参数规格

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	最 大 值	单 位
正向压降	V_F	$I_F=10\text{A}(T_C=25^{\circ}\text{C})$	--	0.92	V
		$I_F=10\text{A}(T_C=125^{\circ}\text{C})$	--	0.80	V
反向漏电流	I_R	$V_R=200\text{V}(T_C=25^{\circ}\text{C})$	--	10	μA
		$V_R=200\text{V}(T_C=125^{\circ}\text{C})$	--	10	mA

典型特性曲线

图1、正向压降典型值

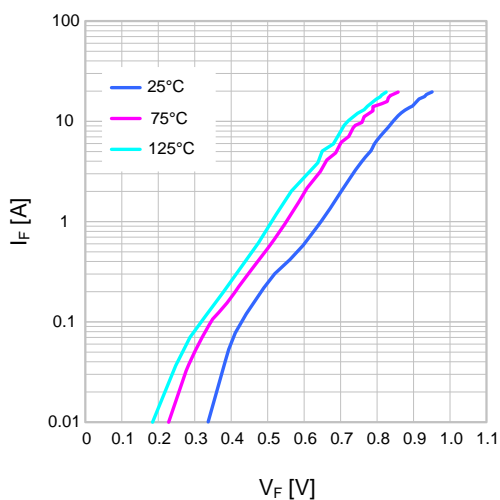


图2、反向漏电流典型值

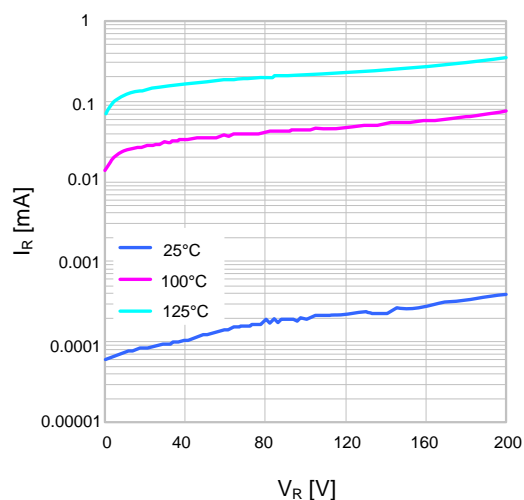


图3、结电容典型值

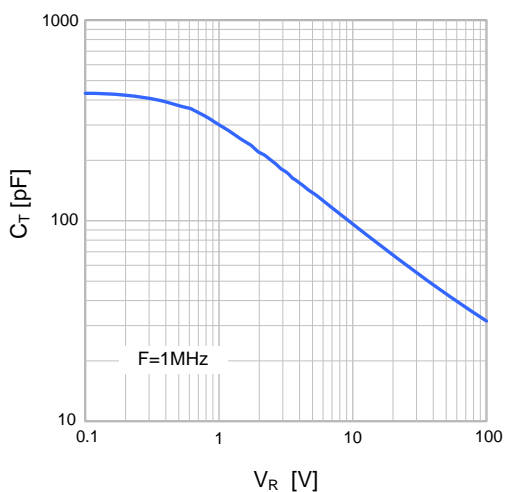
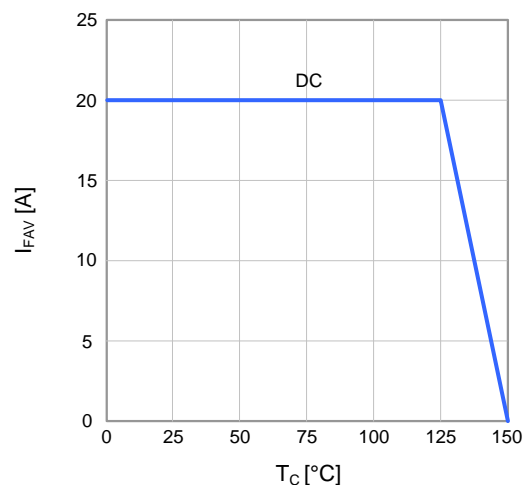


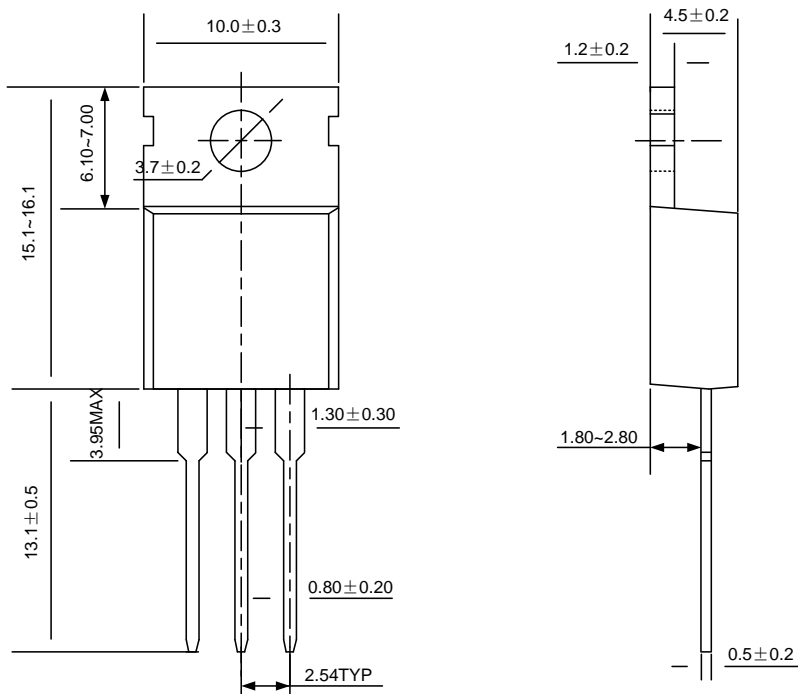
图4、正向平均整流电流



封装外形图

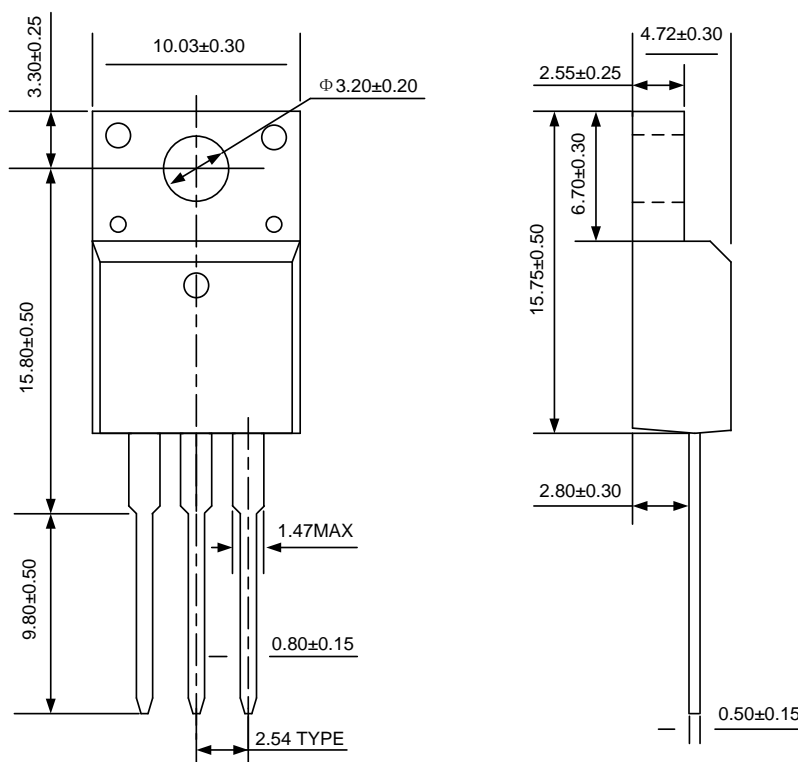
TO-220-3L

单位: mm

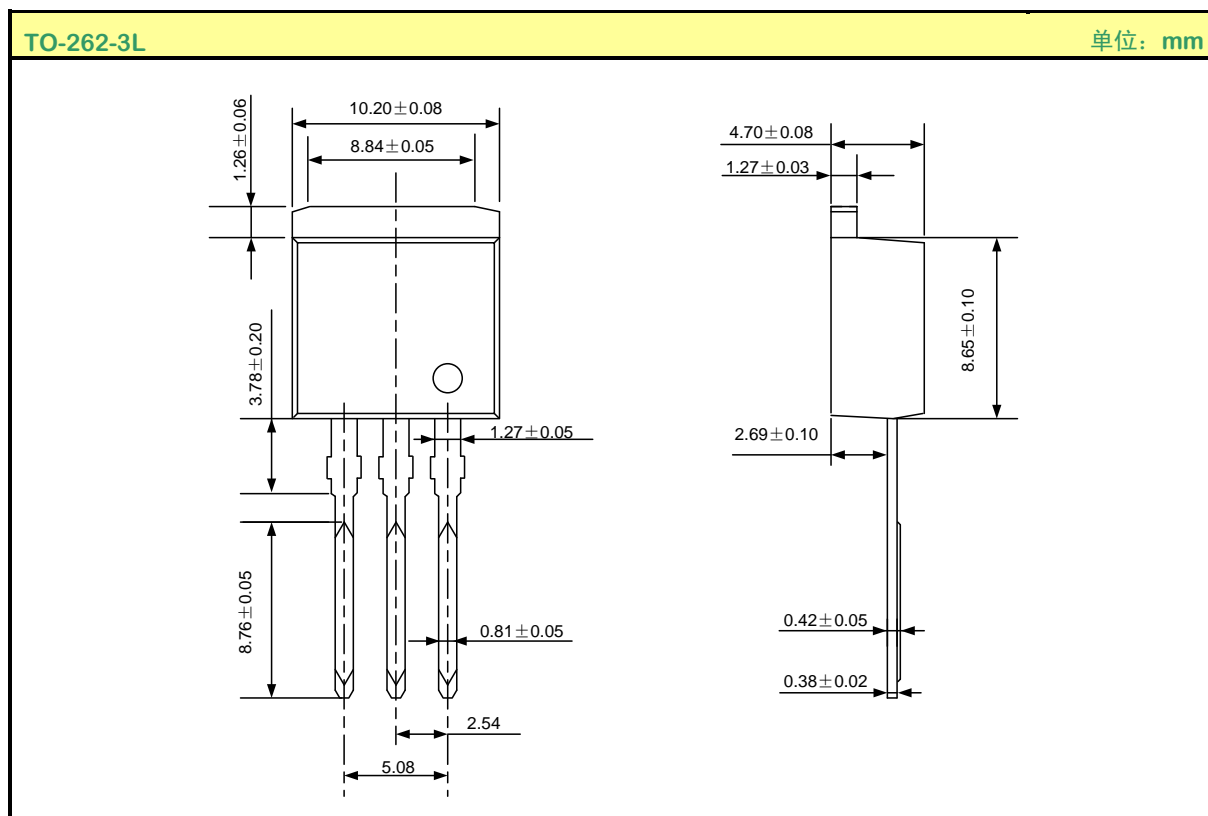


TO-220F-3L

单位: mm



封装外形图（续）



声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附：

修改记录：

日 期	版本号	描 述	页 码
2012.07.30	1.0	原版	
2012.09.28	1.1	修改图4	
2012.10.26	1.2	增加TO-262-3L封装	